

SOT223 NPN SILICON PLANAR MEDIUM POWER HIGH GAIN TRANSISTOR

ISSUE 3 - OCTOBER 1995

FEATURES

- * Extremely low equivalent on resistance; $R_{CE(sat)}$ **83mΩ at 3A**
- * Gain of 400 at $I_C=3$ Amps and very low saturation voltage

APPLICATIONS

- * Flash gun convertors & Battery powered circuits

PARTMARKING DETAIL – FZT688B

COMPLEMENTARY TYPE - FZT788B

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

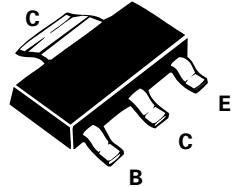
PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	12	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	12	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	5	V
Peak Pulse Current	I_{CM}	10	A
Continuous Collector Current	I_C	4	A
Power Dissipation at $T_{amb}=25^{\circ}C$	P_{tot}	2	W
Operating and Storage Temperature Range	$T_j; T_{stg}$	-55 to +150	$^{\circ}C$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^{\circ}C$)

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Breakdown Voltages	$V_{(BR)CBO}$	12			V	$I_C=100\mu A$
	$V_{(BR)CEO}$	12			V	$I_C=10mA^*$
	$V_{(BR)EBO}$	5			V	$I_E=100\mu A$
Collector Cut-Off Current	I_{CBO}			0.1	μA	$V_{CB}=10V$
Emitter Cut-Off Current	I_{EBO}			0.1	μA	$V_{EB}=4V$
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$			0.04	V	$I_C=0.1A, I_B=1mA$
				0.06	V	$I_C=0.1A, I_B=0.5mA^*$
				0.18	V	$I_C=1A, I_B=50mA^*$
				0.35	V	$I_C=3A, I_B=20mA^*$
				0.40	V	$I_C=4A, I_B=50mA^*$
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$			1.1	V	$I_C=3A, I_B=20mA^*$
Base-Emitter Turn-On Voltage	$V_{BE(on)}$			1.0	V	$I_C=3A, V_{CE}=2V$
Static Forward Current Transfer Ratio	h_{FE}	500				$I_C=0.1A, V_{CE}=2V^*$
		400				$I_C=3A, V_{CE}=2V^*$
		100				$I_C=10A, V_{CE}=2V^*$
Transition Frequency	f_T	150			MHz	$I_C=50mA, V_{CE}=5V$ $f=50MHz$
Input Capacitance	C_{ibo}		200		pF	$V_{EB}=0.5V, f=1MHz$
Output Capacitance	C_{obo}		40		pF	$V_{CB}=10V, f=1MHz$
Switching Times	t_{on}		40		ns	$I_C=500mA, I_{B1}=50A$
	t_{off}		500		ns	$I_{B2}=50mA, V_{CC}=10V$

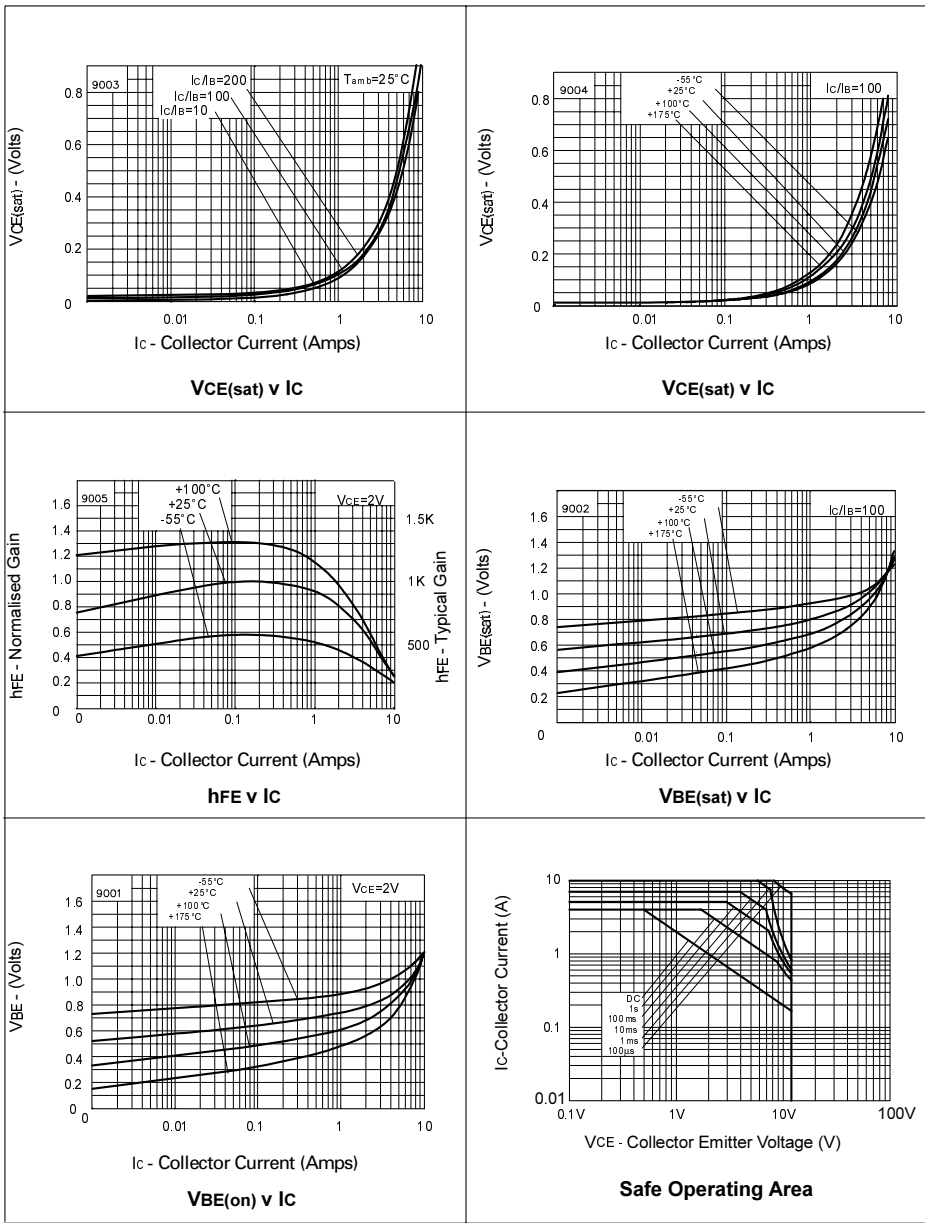
*Measured under pulsed conditions. Pulse width=300 μs . Duty cycle $\leq 2\%$
Spice parameter data is available upon request for this device

FZT688B



FZT688B

TYPICAL CHARACTERISTICS





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.